

Declaration and Power of Attorney For Patent Application

特許出願宣言書及び委任状

Japanese Language Declaration

日本語宣言書

下記の氏名の発明者として、私は以下の通り宣言します。

As a below named inventor, I hereby declare that:

私の住所、私書箱、国籍は下記の私の氏名の後に記載された通りです。

My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name.

下記の名称の発明に関して請求範囲に記載され、特許出願している発明内容について、私が最初かつ唯一の発明者(下記の氏名が一つの場合)もしくは最初かつ共同発明者であると(下記の名称が複数の場合)信じています。

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled

SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF MANUFACTURING THEREOF

上記発明の明細書(下記の欄で×印がついていない場合は、本書に添付)は、

The specification of which is attached hereto unless the following box is checked:

☐ __月__日に提出され、米国出願番号または特許協定条約国際出願番号を__ __ __ __ __とし、(該当する場合) __ __ __ __ __に訂正されました。

☐ was filed on __ __ __ __ __ as United States Application Number __ __ __ __ __ or PCT International Application Number and was amended on __ __ __ __ __ (if applicable).

私は、特許請求範囲を含む上記訂正後の明細書を検討し、内容を理解していることをここに表明します。

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

私は、連邦規則法典第37編第1条56項に定義されるとおり、特許資格の有無について重要な情報を開示する義務があることを認めます。

I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56.

Japan s Language Declaration (日本語宣言書)

私は、米国法典第 35 編 119 条(a)-(d)項又は 365 条(b)項に基き下記の、米国以外の国の少なくとも一カ国を指定している特許協力条約 365(a)項に基く国際出願、又は外国での特許出願もしくは発明者証の出願についての外国優先権をここに主張するとともに、優先権を主張している、本出願の前に出願された特許または発明者証の外国出願を以下に、枠内をマークすることで、示しています。

I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code, Section 119(a)-(d) or 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or 365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States, listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

Prior Foreign Application(s)

外国での先行出願

<u>2003-002667</u>	<u>Japan</u>
(Number) (番号)	(Country) (国名)
<u> </u>	<u> </u>
(Number) (番号)	(Country) (国名)
<u> </u>	<u> </u>
(Number) (番号)	(Country) (国名)

Priority Not Claimed

優先権主張なし

<u>January 8, 2003</u>	<input type="checkbox"/>
(Day/Month/Year Filed) (出願年月日)	
<u> </u>	<input type="checkbox"/>
(Day/Month/Year Filed) (出願年月日)	
<u> </u>	<input type="checkbox"/>
(Day/Month/Year Filed) (出願年月日)	

私は、第 35 編米国法典 119 条(e)項に基いて下記の米国特許出願規定に記載された権利をここに主張いたします。

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 119(e) of any United States provisional application(s) listed below.

<u> </u>	<u> </u>
(Application No.) (出願番号)	(Filing Date) (出願日)

<u> </u>	<u> </u>
(Application No.) (出願番号)	(Filing Date) (出願日)

私は、下記の米国法典第 35 編 120 条に基いて下記の米国特許出願に記載された権利、又は米国を指定している特許協力条約 365 条(c)に基く権利をここに主張します。また、本出願の各請求範囲の内容が米国法典代 35 編 112 条第 1 項又は特許協力条約で規定された方法で先行する米国特許出願に開示されていない限り、その先行米国出願提出日以降で本出願書の日本国内または特許協力条約国際提出日までの期間中に入手された、連邦規制法典第 37 編 1 条 56 項で定義された特許資格の有無に関する重要な情報について開示義務があることを認識しています。

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 120 of any United States application(s), or 365(c) of any PCT International application designating the United States, listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT International application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code Section 112, I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT International filing date of application.

(Application No.) (出願番号)	(Filing Date) (出願日)	(Status: Patented, Pending, Abandoned) (現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.) (出願番号)	(Filing Date) (出願日)	(Status: Patented, Pending, Abandoned) (現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.) (出願番号)	(Filing Date) (出願日)	(Status: Patented, Pending, Abandoned) (現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.) (出願番号)	(Filing Date) (出願日)	(Status: Patented, Pending, Abandoned) (現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.) (出願番号)	(Filing Date) (出願日)	(Status: Patented, Pending, Abandoned) (現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.) (出願番号)	(Filing Date) (出願日)	(Status: Patented, Pending, Abandoned) (現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.) (出願番号)	(Filing Date) (出願日)	(Status: Patented, Pending, Abandoned) (現況: 特許許可済、継続中、放棄済)
(Application No.) (出願番号)	(Filing Date) (出願日)	(Status: Patented, Pending, Abandoned) (現況: 特許許可済、継続中、放棄済)

私は、私自身の知識に基いて本宣言書中で私が行う表明が真実であり、かつ私の入手した情報と私の信じることに基く表明が全て真実であると信じていること、さらに故意になされた虚偽の表明及びそれと同等の行為は米国法典第 18 編第 1001 条に基き、罰金または拘禁、もしくはその両方により処罰されること、そしてそのような故意による虚偽の声明を行えば、出願した、又は既に許可された特許の有効性が失われることを認識し、よってここに上記のごとく宣誓を致します。

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

唯一または第一発明者名	Full name of sole or first inventor Kazuo NISHI
発明者の署名	Inventor's signature <i>Kazuo Nishi</i>
日付	Date 12/19/03.
住所	Residence Minamiarupusu, Yamanashi, Japan
国籍	Citizenship Japanese
私書箱	Post Office Address c/o Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. 398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Japan

第二共同発明者名	Full name of second joint inventor, if any Toru TAKAYAMA		
第二共同発明者の署名	日付	Second inventor's signature	Date
		<i>Toru Takayama</i>	12/19/2003
住所	Residence Atsugi, Kanagawa, Japan		
国籍	Citizenship Japanese		
私書箱	Post Office Address c/o Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. 398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Japan		

第三共同発明者名	Full name of third joint inventor, if any Yuugo GOTO		
第三共同発明者の署名	日付	Third inventor's signature	Date
		<i>Yuugo Goto</i>	12/19/2003
住所	Residence Atsugi, Kanagawa, Japan		
国籍	Citizenship Japanese		
私書箱	Post Office Address c/o Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. 398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Japan		

第四共同発明者名	Full name of fourth joint inventor, if any		
第四共同発明者の署名	日付	Fourth inventor's signature	Date
住所	Residence		
国籍	Citizenship		
私書箱	Post Office Address		